



Toshiba lance un MOSFET de puissance canal N de 1,4 m Ω et 80 V destiné aux équipements industriels à haut rendement

La gamme U-MOS11-H offre de faibles pertes et une capacité de courant de drain élevée dans un boîtier compact de 4,9 × 6,1 mm

Düsseldorf, Allemagne, le 30 juin 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») a lancé le TPM1R408RH, un MOSFET de puissance canal N de 80 V basé sur sa toute dernière technologie de fabrication U-MOS11-H. Conçu pour les alimentations à découpage industrielles à haut rendement destinées aux centres de données et aux stations de base de communication, ce nouveau composant allie une résistance à l'état passant ($R_{DS(ON)}$) ultra-faible à une commutation rapide, permettant ainsi aux concepteurs d'améliorer l'efficacité des systèmes et de réduire les pertes de puissance.

Comparé au TPM1R908QM, un produit 80 V utilisant le procédé U-MOS X-H de génération précédente, le TPM1R408RH atteint une $R_{DS(ON)}$ inférieure d'environ 26 %, soit 1,4 m Ω (max.) à une tension grille-source (V_{GS}) de 10 V et un courant de drain (I_D) de 50 A, contribuant ainsi à minimiser les pertes par conduction dans les applications de puissance exigeantes.

Pour améliorer encore l'efficacité, ce nouveau MOSFET optimise le compromis entre la $R_{DS(ON)}$ et la charge totale de grille (Q_g), atteignant 80 nC. Le facteur de mérite (FOM) [$R_{DS(ON)} \times Q_g$] est environ 45 % inférieur (1,4 m $\Omega \times 80$ nC = 112 m $\Omega \cdot$ nC) à celui du TPM1R908QM (1,9 m $\Omega \times 108$ nC = 205,2 m $\Omega \cdot$ nC). Ces caractéristiques réduisent les pertes de commutation et suppriment les pics de tension générés entre le drain et la source lors de la commutation, contribuant ainsi à réduire les interférences électromagnétiques (EMI) et à permettre une commutation à haute vitesse dans les alimentations à découpage (SMPS).

Le TPM1R408RH supporte une tension drain-source de 80 V et un courant de drain maximal (I_D) de 288 A ($T_c = 25$ °C), ce qui le rend adapté aux applications industrielles à courant élevé. Ce composant est logé dans le boîtier compact SOP Advance(E) de

Toshiba, qui réduit la résistance du boîtier d'environ 65 % et la résistance thermique d'environ 15 % par rapport au boîtier SOP Advance(N) existant, favorisant ainsi la conception de systèmes compacts.

Toshiba propose également des outils d'aide à la conception de circuits pour alimentations à découpage. Outre le modèle G0 SPICE, qui permet une vérification rapide du fonctionnement des circuits, des [modèles G2 SPICE](#) de haute précision, reproduisant les caractéristiques transitoires, sont désormais disponibles.

Toshiba continuera d'enrichir sa gamme de MOSFET de puissance qui améliorent l'efficacité des alimentations et contribuent ainsi à réduire la consommation d'énergie des équipements.

Suivez ce lien pour en savoir plus : [TPM1R408RH](#)

###

À propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre aux consommateurs et aux entreprises d'Europe une grande variété de lecteurs de disques durs (*hard disk drive*, HDD) ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour l'automobile, l'industrie, l'IoT, le contrôle de mouvement, les télécommunications, les réseaux, la grande consommation et les produits blancs. Outre les disques durs, le vaste portefeuille de l'entreprise comprend des semi-conducteurs de puissance et d'autres composants discrets allant des diodes aux circuits intégrés logiques et aux semi-conducteurs optiques, ainsi que des microcontrôleurs et des produits standard spécifiques à l'application (*application specific standard products*, ASSP), entre autres. En outre, TEE propose également des cellules et des modules de batterie SCiB™ avec de l'oxyde de lithium et de titane (LTO) pour les applications les plus exigeantes.

TEE a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, et des succursales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni qui fournissent des services de marketing, de vente et de logistique.

Visitez les sites Web de Toshiba à www.toshiba.semicon-storage.com et www.scib.jp/en pour plus d'informations sur la société et ses produits.

Contact pour publication :

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0

Web : www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contact presse :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe

Tél : +44 (0)7464 493526

E-mail : MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0) 172 617 8431

Web: www.pretzl.com

E-mail : birgit.schoeniger@pretzl.com

Jun 2026

Ref. 7695F